

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成19年8月23日(2007.8.23)

【公開番号】特開2002-26389(P2002-26389A)

【公開日】平成14年1月25日(2002.1.25)

【出願番号】特願2000-207701(P2000-207701)

【国際特許分類】

H 01 L 33/00 (2006.01)

C 23 C 16/34 (2006.01)

H 01 L 21/205 (2006.01)

H 01 L 21/324 (2006.01)

【F I】

H 01 L 33/00 C

C 23 C 16/34

H 01 L 21/205

H 01 L 21/324 C

【手続補正書】

【提出日】平成19年7月5日(2007.7.5)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0076

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0076】

第2の実施形態と同様にしてMOCVD法により製造した多層構造を有するウェーハについて、第2の実施形態と同様の方法で表面にCo薄膜を形成し、酸素を含む窒素ガス雰囲気中で10分間の熱処理を施すことでAlGaN層中のMgを活性化するとともに、Co薄膜を除去し、AlGaNからなるp型層を製造した。